

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成24年5月24日(2012.5.24)

【公開番号】特開2011-60402(P2011-60402A)

【公開日】平成23年3月24日(2011.3.24)

【年通号数】公開・登録公報2011-012

【出願番号】特願2009-211544(P2009-211544)

【国際特許分類】

G 11 C 11/412 (2006.01)

G 11 C 11/41 (2006.01)

G 11 C 11/413 (2006.01)

【F I】

G 11 C 11/40 3 0 1

G 11 C 11/34 3 4 5

G 11 C 11/34 M

【手続補正書】

【提出日】平成24年3月28日(2012.3.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

データの読み出し又は書き込みが行われる第1のメモリセルが行列状に複数配置された第1のメモリセルアレイと、

対応する列に配置された複数の前記第1のメモリセルのうち、何れかの第1のメモリセルのデータを增幅し記憶する第2のメモリセルが、行列状に複数配置された第2のメモリセルアレイと、を備え、

前記第1及び前記第2のメモリセルアレイは、互いに列方向に対向配置され、

前記第2のメモリセルは、前記第1のメモリセルよりも面積が大きく、

前記第1のメモリセルアレイは、前記第2のメモリセルアレイの2倍以上の面積である半導体記憶装置。